1. (a) の回路における電力の導出

3. (c) の回路における電力の導出

入力電圧の最大値を
$$E_m$$
とすると $e=E_m\sin\omega t$ $i=\frac{e}{R}=\frac{E_m}{R}\sin\omega t$ $ei=E_m\sin\omega t\cdot\frac{E_m}{R}\sin\omega t$ $=\frac{E_m^2}{R}\sin^2\omega t$ $=\frac{E_m^2}{R}\left(1-\cos2\omega t\right)$ $E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}$ より、 $E_m^2=2E^2$ であるから、 $ei=ei_R=\frac{E^2}{R}\left(1-\cos2\omega t\right)$

2. (b) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E \sin \omega t$$
インダクタンス L [H] に流れる電流を i [A] とすると、誘導起電力 e_L [V] は
 $e_L = -L\frac{di}{dt}$
 $e + e_L = 0$ が成り立つため、
 $e = L\frac{di}{dt}$

$$\frac{e}{L}dt = di$$

$$\int di = \int \frac{e}{L}dt$$
 $i = \int \left(\sqrt{2}E \sin \omega t dt\right)$
 $= -\sqrt{2}\frac{E}{\omega L}\cos \omega t$
 $= \sqrt{2}\frac{E}{\omega L}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$
 $ei = \frac{2E^2}{\omega L}\sin \omega t \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$
積和の公式
 $\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2}\left(\cos\left(\alpha + \beta\right) - \cos\left(\alpha - \beta\right)\right)$
を用いて変形すると
 $ei = \frac{2E^2}{\omega L}\left(-\frac{1}{2}\left(\cos\left(\omega t + \omega t - \frac{\pi}{2}\right)\right) - \cos\left(\omega t - \omega t + \frac{\pi}{2}\right)\right)$
 $= -\frac{E^2}{\omega L}\cos\left(2\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

$$e = \sqrt{2}E \sin \omega t$$
 静電容量 C [F] に加わる電圧を v [V] とすると、流れる電流 i [A] は
$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}Cv$$

$$= C\frac{d\left(\sqrt{2}E \sin \omega t\right)}{dt}$$

$$= \sqrt{2}\omega CE \cos \omega t$$
 これらから、電力 ei は
$$ei = 2E^2\omega C \sin \omega t \cos \omega t$$

$$= E^2\omega C \sin (2\omega t)$$

4. (d) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E\sin\omega t$$

また、各素子の電圧降下の合成と考えると

$$e = iR + L\frac{di}{dt}$$
とも表すことができる.

抵抗とリアクタンスの合成インピーダンスを Z, 合成インピーダンスの位相のずれを Φ とすると 電流 i は、

$$i = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin\left(\omega t - \Phi\right)$$

このiを用いて電力eiを表すと、

$$ei = \sqrt{2}E \sin \omega t \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin (\omega t - \Phi)$$
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \omega t \sin (\omega t - \Phi)$$

加法定理を用いて、 $\sin(\omega t - \Phi)$ を変形すると

$$ei = \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \omega t \left(\sin \omega t \cos \Phi - \cos \omega t \sin \Phi\right)$$

$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin^2 \omega t \cos \Phi - \sin \omega t \cos \omega t \sin \Phi\right)$$

$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin^2 \omega t \cos \Phi\right) - \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin \omega t \cos \omega t \sin \Phi\right)$$

左の項には sin の半角公式

右の項には $\sin \alpha \cos \beta$ の積和公式を用いて変形すると

$$ei = \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) \cos \Phi \right)$$
$$- \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\frac{1}{2} \left(\sin 2\omega t + \sin 0 \right) \sin \Phi \right)$$
$$= \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2\omega t \right) - \frac{E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \sin 2\omega t$$

また、各素子における電力を求める.

抵抗での電圧降下 e_R は、

$$e_R = iR = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}R\sin\left(\omega t - \Phi\right)$$

であるから.

$$\begin{aligned} ei_R &= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} R \sin \left(\omega t - \Phi\right) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin \left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} R \sin^2 \left(\omega t - \Phi\right) \end{aligned}$$

半角の公式を用いて

$$\begin{split} &=\frac{2E^2}{\|Z\|^2}R\left(\frac{1-\cos2\left(\omega t-\Phi\right)}{2}\right)\\ &=\frac{E^2}{\|Z\|^2}R\left(1-\cos2\left(\omega t-\Phi\right)\right) \end{split}$$

R と ωL との位相差は $\frac{\pi}{2}$ であり、

- 合成インピーダンス Z の位相差を Φ とすると,

$$rac{R}{\|Z\|}=\cos\Phi$$
となるため, $ei_R=rac{E^2}{\|Z\|}\cos\Phi\left(1-\cos2\left(\omega t-\Phi
ight)
ight)$

次にコイルでの電圧降下 e_L は、

$$e_{L} = L\frac{di}{dt} = L\frac{d}{dt} \left(\frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin(\omega t - \Phi)\right)$$
$$= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\omega L\cos(\omega t - \Phi)$$

$$ei_{L} = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \omega L \cos(\omega t - \Phi) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin(\omega t - \Phi)$$
$$= \frac{2E^{2}}{\|Z\|^{2}} \omega L \cos(\omega t - \Phi) \sin(\omega t - \Phi)$$

積を和に直す公式を用いて変形すると,